Лабораторная работа № 260-2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ γ-ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

Цель работы: изучить механизмы взаимодействия *γ*-излучения с веществом; измерить функцию пропускания и рассчитать коэффициент поглощения *γ*-излучения Cs-137 в алюминиевом и свинцовом поглотителях; определить энергию *γ*-излучения.

введение

При прохождении ядерного излучения через вещество его энергия передается окружающей среде, изменяя ее свойства. Механизмы взаимодействия излучения с веществом важно знать для того, чтобы уметь регистрировать излучение, а также представлять степень биологической опасности и применять эффективные меры защиты. Данная работа посвящена изучению взаимодействия γ-излучения с веществом.

К γ-излучению относят электромагнитные волны, испускаемые при ядерных превращениях или аннигиляции частиц. В квантовой теории это излучение представляет собой поток частиц, называемых γ-квантами. Нижний предел энергии γ-квантов имеет порядок десятков килоэлектронвольт (кэВ). Естественного верхнего предела энергии нет.

В основе поглощения у-излучения веществом лежит электромагнитное взаимодействие.

При прохождении пучка γ-квантов через вещество они вступают во взаимодействие с атомами и вызывают ряд явлений, при этом γ-квант или поглощается целиком, или теряет часть своей энергии, изменяя направление распространения. Реализация того или иного механизма взаимодействия γ-квантов с веществом носит вероятностный характер и зависит как от свойств самого γ-излучения (его энергии), так и от свойств вещества (например, его плотности и элементного состава).

ПРОХОЖДЕНИЕ *ү* - ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕЩЕСТВО

Пусть на поглотитель падает монохроматический параллельный пучок γ -квантов. Число взаимодействий (рассеяний и поглощений) в бесконечно тонком слое вещества поглотителя dx пропорционально концентрации атомов в веществе поглотителя a, интенсивности падающего пучка N:

$$-dN = a\sigma Ndx . (1)$$

Полагая, что каждый акт взаимодействия приводит к выбыванию γ - кванта из пучка, после интегрирования в выражении (1) получаем закон ослабления γ -квантов в веществе поглотителя:

$$N = N_0 e^{-a\sigma x},\tag{2}$$

где N – число γ -квантов с энергией E_{γ} после прохождения слоя поглотителя равного x; N_0 – число γ -квантов с той же энергией, падающих на поглотитель; σ – эффективное сечение взаимодействия γ -квантов.

Эффективное сечение играет фундаментальную роль в ядерной физике при описании ядерных взаимодействий, так как характеризует интенсивность процесса. Его величина зависит от энергии γ -квантов E_{γ} и от среднего эффективного заряда вещества поглотителя Z. Сечение имеет размерность площади [σ] = L^2 .

Произведение $a\sigma$ называется линейным коэффициентом ослабления τ моноэнергетического пучка γ -квантов; $[\tau] = 1/L$.

В некоторых случаях удобнее пользоваться массовым коэффициентом ослабления µ:

$$\mu = \tau / \rho, \tag{3}$$

где ρ – плотность вещества; $[\rho] = M/L^3$. Размерность коэффициента μ равна $[\mu] = L^2/M$. Массовый коэффициент μ зависит от энергии γ -квантов E_{γ} , Z вещества поглотителя и концентрации атомов в веществе a.

Таким образом, для моноэнергетического параллельного пучка у-квантов выражение (2) можно записать в виде

$$N = N_0 e^{-\mu \rho x} = N_0 e^{-\mu d}, \qquad (4)$$

где массовая толщина *d* равняется ρx ; $[d] = M/L^2$.

Необходимо отметить, что выражение (4) справедливо, если пучок γ -квантов моноэнергетический и нерасходящийся. Если пучок содержит γ -кванты различных энергий $E_{\gamma i}$, выражение (4) принимает вид:

$$N = \sum N_{0i} e^{-\mu_i d} ,$$

где суммирование ведется по всем энергиям, так как коэффициент ослабления зависит от энергии ү-квантов. Если пучок расходящийся, необходимо учесть зависимость пути *x*, проходимого излучением в поглотителе, от направления распространения излучения. Подчеркнем, что в выражениях (2) и (4), описывающих уменьшение числа γ -квантов, величина N – это число γ -квантов, прошедших поглотитель толщиной *х без взаимодействия*. Следовательно, число провзаимодействовавших γ -квантов в поглотителе толщиной *х* равно

$$N_0 - N = N_0 (1 - e^{-\mu d}).$$

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ γ-ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

Известно большое число различных взаимодействий γ -излучения с веществом. Практический же интерес представляют следующие три процесса: фотоэлектрическое поглощение γ -кванта (фотоэффект), рассеяние γ -кванта на электронах (комптон-эффект) и рождение γ -квантом электрон-позитронных пар (эффект образования пар).

Фотоэффект

Если энергия γ -кванта E_{γ} больше энергии связи какого-нибудь электрона оболочки атома ($E_{\gamma} >> I_i$), то может иметь место фотоэлектрическое поглощение γ -кванта (фотоэффект). Явление фотоэффекта состоит в том, что энергия γ -кванта E_{γ} целиком поглощается атомом, а один из электронов оболочки, называемый фотоэлектроном, выбрасывается за пределы атома. Используя закон сохранения энергии, можно определить кинетическую энергию фотоэлектрона E_e :

$$E_e = E_{\gamma} - E_{\mathfrak{A}\mathfrak{A}} - I_i. \tag{5}$$

 $E_{\rm sqd}$ – энергия отдачи ядра; однако величина энергии отдачи ядра $E_{\rm sqd}$ мала вследствие того, что масса ядра $m_{\rm sqd}$ значительно больше массы электрона $m_0: m_{\rm sqd} >> m_0$; поэтому в выражении (5) членом $E_{\rm sqd}$ можно пренебречь. Следовательно, при фотоэффекте электрону, выброшенному за пределы атома, передается почти вся энергия падающего γ -кванта, а γ -квант перестает существовать. I_i – ионизационный потенциал соответствующей *i*-оболочки атома (i = K, L, M...).

Атом, потерявший электрон, оказывается в возбужденном состоянии; освободившийся уровень энергии в атоме заполняется электроном с выше расположенной оболочки. Этот процесс сопровождается либо испусканием характеристического рентгеновского излучения, либо испусканием электрона Оже.

Вероятность вылета фотоэлектронов под некоторым углом φ к направлению полета γ -кванта зависит от энергии фотоэлектронов E_e , которую им передал γ -квант: при малых энергиях E_e фотоэлектроны испускаются преимущественно в направлении, перпендикулярном пучку γ -квантов; с ростом E_e средний угол вылета фотоэлектронов φ уменьшается. На рис. 1 приведено угловое распределение фотоэлектронов.



Рис. 1. Угловое распределение фотоэлектронов

При $m_0 c^2 > E_{\gamma} >> I_i (i = K)$ сечение σ_{ϕ} меняется по закону $\sigma_{\phi} \approx (1/E_{\gamma})^{\frac{7}{2}},$

а при $E_{\gamma} >> m_0 c^2$ – по закону

$$\sigma_{\oplus} \approx (1/E_{\gamma}).$$

При очень больших энергиях E_{γ} сечение фотоэффекта σ_{ϕ} становится очень мало, так как для фотоэффекта существенна связь электрона с атомом, которому передается часть импульса фотона: чем меньше связь электрона с атомом по сравнению с энергией фотона E_{γ} , тем менее вероятен фотоэффект. Это означает, что при высоких энергиях вклад фотоэффекта в ослабление пучка γ -квантов гораздо меньше, чем при более низких энергиях (см. рис. 2). Кроме того, величина сечения фотоэффекта σ_{ϕ} резко зависит от среднего эффективного заряда вещества Z:

$$\sigma_{\phi} \sim Z^5$$
,

что так же объясняется различной связанностью электронов. В легких элементах электроны связаны кулоновскими силами ядра относительно слабее, чем в тяжелых. Поэтому фотоэффект особенно существенен для тяжелых веществ, где он идет с заметной вероятностью даже при высо-

ких энергиях. Следовательно, для ослабления пучка γ -квантов необходимо использовать вещества с большим Z.



Рис. 2. Зависимость сечения фотоэффекта от энергии у-излучения

Комптон-эффект

Если энергия γ -квантов существенно превышает энергию связи электронов в атоме, то, рассматривая рассеяние γ -квантов на электронах, можно считать последние свободными (или слабо связанными). Такое рассеяние γ -квантов называют комптоновским рассеянием или комптон-эффектом. В результате комптон-эффекта вместо первичного фотона с энергией E_{γ} появляется рассеянный фотон с энергией $E_{\gamma'} < E_{\gamma}$, а электрон, на котором произошло рассеяние, называемый электроном отдачи или комптон-электроном, приобретает кинетическую энергию, равную

$$E_e = E_{\gamma} - E_{\gamma'}.$$

Пользуясь законами сохранения энергии и импульса, можно показать, что энергия рассеянного γ -кванта $E_{\gamma'}$ уменьшается с ростом угла рассеяния θ . Убывание энергии рассеянного γ -кванта $E_{\gamma'}$ с ростом угла рассеяния θ соответствует возрастанию энергии электрона отдачи E_e :

$$E_{\gamma'} = \frac{E_{\gamma}}{\left[1 + (1 - \cos\theta)\varepsilon\right]};$$

$$E_e = E_{\gamma} \left[\frac{2\varepsilon}{1 + 2\varepsilon + (1 + \varepsilon)^2 \operatorname{tg}^2 \Psi}\right],$$
(6)

где $\varepsilon = E_{\gamma} / m_0 c^2$, а Ψ – угол вылета комптон-электрона.

Так как угол θ рассеяния γ -кванта может меняться от 0 до 180°, то энергия рассеянного γ -кванта $E_{\gamma'}$ (как видно из (6)) уменьшается от E_{γ} до $E'_{\gamma M U H}$:

$$E'_{\gamma M \mu H} = E_{\gamma} / (1 + 2 \varepsilon).$$

Однако с изменением угла θ от 0 до 180° угол вылета электрона отдачи изменяется от 90° до 0. При этом энергия электрона отдачи E_e возрастает от 0 до E_{emakc} :

$$E_{e\text{MAKC}} = 2\varepsilon E_{\gamma} / (1 + 2\varepsilon)$$
.

На рис. 3 приведен энергетический спектр комптоновских электронов отдачи.



Рис. 3. Энергетический спектр комптоновских электронов отдачи

Из рис. З видно, что при высоких энергиях E_e распределение комптон-электронов почти равновероятно, за исключением области вблизи максимальной энергии электронов $E_{e_{Makc}}$. Электроны отдачи при комптон-эффекте вылетают преимущественно вдоль первоначального направления движения γ -квантов: чем выше энергия падающих γ -квантов, тем эта анизотропия сильнее.

Зависимость величины сечения рассеяния σ_{κ} γ -квантов на свободном (слабо связанном) электроне показана на рис. 4. С увеличением энергии γ -кванта E_{γ} сечение комптоновского рассеяния σ_{κ} убывает по закону:

$$\sigma_{\kappa} \sim Z / E_{\gamma}$$

Это означает, что с увеличением E_{γ} и уменьшением Z вклад комптоновского рассеяния в ослабление пучка γ -квантов падает.

Эффект образования электрон - позитронных пар

При достаточно высокой энергии γ -квантов ($E_{\gamma} > E_{nop}$) наряду с фотоэффектом и эффектом Комптона может происходить третий вид взаимодействия γ -квантов с веществом – образование электрон-позитронных пар. Из законов сохранения импульса и энергии можно показать, что процесс образования пар не может происходить в вакууме. Процесс рождения пар происходит лишь в кулоновском поле какой-либо частицы, получающей часть импульса и энергии. Такой частицей может быть или атомное ядро, или электрон. При этом если процесс образования пары идет в кулоновском поле ядра, необходимо выполнить неравенство

$$E_{\gamma} \ge 2m_0 c^2 + E_{\mathfrak{s}} , \qquad (7)$$

где $2m_0c^2$ соответствует энергии рождения пары электрон-позитрон, а $E_{\rm s}$ – энергия отдачи ядра. Так как энергия отдачи ядра сравнительно мала, то ею можно пренебречь. Первый член, стоящий в правой части неравенства (7), принято называть порогом рождения пар $E_{\rm nop}$.

Сечение образования пар σ_{Π} в поле атомного ядра пропорционально Z^2 и растет с увеличением энергии γ -кванта E_{γ} . Выражение для сечения образования пар в поле ядра имеет достаточно сложный вид. В наиболее упрощенном аналитическом виде оно может быть представлено только для энергий E_{γ} в интервале $5m_0c^2 < E_{\gamma} < 50m_0c^2$:

$$\sigma_{\Pi} \sim Z^2 \ln E_{\gamma}.$$

Итак, полное сечение взаимодействия γ -квантов с веществом является суммой трех сечений σ_{φ} , σ_{κ} , σ_{π} :

$$\sigma = \sigma_{\oplus} + \sigma_{\kappa} + \sigma_{\Pi},$$

где каждая из величин σ_{ϕ} , σ_{κ} , σ_{Π} по-разному зависит от энергии үкванта E_{γ} и Z. Вследствие этого в разных областях энергий ү-квантов и значений Z тот или иной механизм взаимодействия γ-излучения с веществом может оказаться доминирующим.

Из характера зависимости сечений от энергии γ -квантов E_{γ} (рис. 4) следует, что в области малых энергий ($E_{\gamma} < E_1$) основным механизмом взаимодействия γ -квантов со средой является фотоэффект; в промежу-

точной области ($E_1 < E_{\gamma} < E_2$) – эффект Комптона, а в области больших энергий ($E_{\gamma} > E_2$) – процесс образования пар (значения E_1 и E_2 различны для различных сред).



Рис. 4. Зависимость величины сечений комптон-эффекта, фотоэффекта и эффекта образования пар от энергии у-квантов

Подводя итоги, можно сказать, что в результате всех трех выше рассмотренных процессов взаимодействия γ -кванты или поглощаются целиком, или теряют часть своей энергии; при этом потерянная ими энергия либо передается атомному электрону, или идет на образование электронпозитронных пар. Вновь образованные заряженные частицы (в основном электроны), проходя через вещество, тоже в свою очередь вызывают ряд явлений (например, ионизация и возбуждение атомов этого вещества). Знание вышеизложенных явлений становится очень важным, когда встает вопрос о способах регистрации γ -квантов.

Несмотря на многообразие процессов взаимодействия γ-квантов, сечения всех этих взаимодействий сравнительно невелики, поэтому γизлучение слабо поглощается веществом.

Необходимо отметить, что кроме вышеописанных трех механизмов взаимодействий γ-излучения с веществом существуют также ядерный фотоэффект, деление ядер и когерентное рассеяние на электронах. Эти процессы не играют заметной роли в ослаблении потока γ-квантов с энергией до нескольких мегаэлектронвольт.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ

Сущность метода измерения массового коэффициента ослабления γ излучения крайне проста. Если N_0 – количество регистрируемых γ квантов за время *t* при x = 0, а N(x) – количество регистрируемых γ квантов за такой же интервал времени после их прохождения через слой вещества толщиной *x*, то из (4) можно получить соотношение

$$N(x)/N_0 = e^{-\mu\rho x}$$
 (8)

Отношение $N(x)/N_0$ называют функцией пропускания B(x). Из (8) получаем выражение для расчета массового коэффициента ослабления:

$$\mu = -\frac{1}{\rho x} \ln \frac{N(x)}{N_0}.$$
(9)

Толщина слоя, после прохождения которого количество регистрируемых γ -квантов уменьшается вдвое, называется слоем половинного ослабления $x_{1/2}$. Величина $x_{1/2}$ связана со значением μ следующим соотношением:

$$\mu = \ln 2 / \rho x_{1/2}$$
.

Зная массовый коэффициент ослабления μ в данном веществе, по известной зависимости μ от E_{γ} для этого вещества можно определить энергию γ -квантов E_{γ} . Такой метод определения энергии γ -квантов называется методом поглощения. И хотя он не претендует на большую

точность, в некоторых случаях может быть полезен из-за простоты реализации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Условия проведения эксперимента

Для определения коэффициента ослабления используется выражение (9). При этом необходимо, чтобы исследуемый пучок ү-квантов был моноэнергетическим и не расходящимся. Моноэнергетическое үизлучение дают немногие радиоактивные изотопы. Одним из таких изотопов является Cs-137, энергетический спектр которого имеет только одну линию с энергией ү-квантов 661 кэВ (рис. 5). При достаточно большом расстоянии от точечного источника излучения до поглотителя расходимостью пучка можно пренебречь и считать пучок практически параллельным.

Формула (4) описывает изменение числа γ -квантов, непровзаимодействовавших в поглотителе, от толщины этого поглотителя. Следовательно, для ее использования необходимо выделить только те зарегистрированные γ -кванты, которые не испытали взаимодействия в веществе поглотителя. В случае фотоэффекта провзаимодействовавший в поглотителе γ -квант выбывает из пучка; в случае комптон-эффекта рассеянный на малый угол γ -квант может все же попасть в детектор и быть зарегистрированным. Для дискриминации таких γ -квантов существуют два способа.



Рис. 5. Схема распада радиоактивного изотопа Cs-137

Первый способ наиболее простой: на пути пучка между поглотителем и детектором устанавливается коллиматор с узким отверстием. Рассеянный в поглотителе ү-квант, изменив свое первоначальное направление, не попадет в отверстие коллиматора и не будет регистрироваться детектором.

Второй способ несколько сложенее и требует устройства, которое различало бы γ-кванты по энергиям (энергия рассеянных γ-квантов меньше энергии γ-квантов, не испытавших взаимодействия в поглотителе). В качестве такого устройства можно использовать сцинтилляционный γ-спектрометр. Амплитудный спектр импульсов с выхода сцинтилляционного детектора подробно описан в лабораторной работе по изучению сцинтилляционного γ-спектрометра.

Гамма-кванты с энергией E_0 , не провзаимодействовавшие в поглотителе и зарегистрированные детектором за счет фотоэффекта, формируют так называемый фотопик (или пик полного поглощения), который должен иметь вид распределения Гаусса (рис. 6). Рассеянные в поглотителе γ -кванты и потерявшие в нем часть своей энергии ($E < E_0$) тоже регистрируются детектором и вносят вклад в те каналы, которые находятся слева от максимума пика полного поглощения. Поэтому задача выделения γ -квантов, не провзаимодействовавших в поглотителе, сводится к выделению в амплитудном спектре пика полного поглощения, соответствующего γ -квантам с энергией E_0 , что осуществляется с помощью спектрометра.



Рис. 6. Амплитудный спектр импульсов на выходе детектора

Геометрия эксперимента



Рис. 7 Геометрия эксперимента

<u>Эксперимент</u>. В качестве детектирующей системы используется детектор на основе кристалла NaI(Tl) фирмы ORTEC. Размеры кристалла составляют 3х3 дюйма.

<u>Детектор на основе NaI(TI) фирмы ORTEC</u> Гамма-кванты, взаимодействуя с веществом сцинтиллятора, вызывают световую вспышку, которая преобразуется в электрический импульс посредством фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). ФЭУ состоит из фотокатода, фокусирующего электрода и 10 или более динодов, умножающих число электронов, падающих на каждый динод. Цепочка резисторов, обычно расположенных в виде делителя на разъеме ФЭУ, обеспечивает потенциалы на динодах и аноде. Таким образом, детектор в комплекте состоит из сцинтиллятора и ФЭУ.

Требования, предъявляемые к таким детекторам – хорошая прозрачность, возможность изготовления больших размеров, и самое главное – максимально большой выход света пропорционально энергии гамма-квантов. Несколько материалов обеспечивают такие параметры – активированный таллием йодид натрия NaI(Tl) и йодид цезия CsI(Tl), а также некоторые пластические сцинтилляторы. CsI(Tl) и пластические сцинтилляторы обладают намного лучшими временнЫми параметрами по сравнению с NaI(Tl) и поэтому часто применяются при необходимости получения лучшего временнОго разрешения.

Высокий Z йода в NaI(Tl) приводит к высокой эффективности регистрации гамма-квантов.

Энергетическое разрешение кристалла NaI(Tl) диаметром 3 дюйма и длиной 3 дюйма составляет около 7% для ¹³⁷Сs и немного ухудшается с увеличением размеров.

ВременнОе разрешение кристалла NaI(Tl) составляет примерно 0.23 мксек. Типовой зарядово-чувствительный предусилитель переводит сигнал с ФЭУ в импульс напряжения с временем нарастания переднего фронта около 0.5 мксек. Быстрое совпадение при таких параметрах невозможно, особенно при низких энериях.



Рис. 8. Детектор на основе NaI(Tl) фирмы ORTEC



Рис. 9. Лабораторная установка с алюминиевыми поглотителями.

Лабораторная работа

Подключение детектора

1. Включить компьютер

- 2. Подключить разъем детектора к входу USB компьютера
- 3. Открыть программу MAESTRO
- 4. Убедиться, что в окне Buffer высвечивается детектор 001USER-PC22MCB130. Если другое – обратиться к руководителю.
- 5. Нажать "Acquire MCB Properties"
- 6. High Voltage ON
- 7. Установить напряжение на детекторе 590 Вольт, если не установлено.

<u>Калибровка детектора радиоактивными источниками ²⁴¹Ат и ¹³⁷Сs</u>

- 1. Достать из сейфа контейнер с радиоктивным источником ²⁴¹Am, извлечь источник из контейнера.
- 2. Установить радиоактивный источник ²⁴¹Ат перед окном детектора.
- 3. Установить время набора спектра, для этого Acquire MCB Properties Preset Real time 500 секунд.
- 4. Начать набор спектра кнопкой "Go" погаснет зеленая индикация "Go", загорится красная индикация "Stop".
- 5. Контролировать показатель мертвого времени набора "Dead Time" в правом верхнем окне должен быть не более 10%.
- 6. По завершении набора загорится индикация "Go".
- 7. На экране высвечивается энергетический спектр от радиоактиваного источника ²⁴¹Am.
- 8. Передвижением курсора стрелками влево-вправо установить курсор на пиковое значение спектра.
- 9. С нижней части экрана считать значение номера канала под названием "Marker".
- 10. "Calculate Calibration Destroy calibration"
- 11.Установить значение энергии излучения от ²⁴¹Am в окне энергии, для ²⁴¹Am это значение составляет 59.54 КэВ.

- 12.Удалить ²⁴¹Ат в контейнер, спрятать в сейф.
- 13.Достать из сейфа контейнер с радиоктивным источником ¹³⁷Cs, извлечь источник из контейнера.
- 14. Установить радиоактивный источник ¹³⁷Сs перед окном детектора.
- 15. Повторить пункты 3-10 для ¹³⁷Сs.
- 16.Установить значение энергии излучения от ¹³⁷Cs в окне энергии, для ¹³⁷Cs это значение составляет 661 КэВ.
- 17.ОК завершить калибровку, выйти из окна калибровки.

Порядок проведения эксперимента

Измерение функции пропускания у- излучения в свинцовом поглотителе

Набрать амплитудные спектры выходных импульсов при 5 различных толщинах *x* свинцового поглотителя, помещаемого между сцинтиллятором и источником. Первое измерение спектра провести в отсутствии поглотителя. Набранные спектры записать в файлы. Сохранить измеренный спектр "File – Save As", выбрать свою директорию (для каждого студента создана своя индивидуальная директория)

"MyDocuments_LabWork_Gamma_Students_StudentName"

(StudentName=Andranik, Armine, Anush or Mher), в двух расширениях – Integer ChN и ASCII SPE, под названием Pb0(1,2,3,4,5). Пояснение: Pb0 – спектр без свинцового поглотителя, Pb1 – спектр с 1 слоем поглотителя и т.д.

2. Аналогично набрать амплитудные спектры выходных импульсов при 5 различных толщинах *х* алюминиевого поглотителя, помещаемого между сцинтиллятором и источником. Первое измерение спектра провести в отсутствии поглотителя. Набранные спектры записать в файлы. Сохранить измеренный спектр "File – Save As", выбрать свою директорию (для каждого студента создана своя индивидуальная директория) "Му Documents_LabWork_Gamma_Students_StudentName" (StudentName=Andranik, Armine, Anush or Mher), в двух расшире-

ниях – Integer ChN и ASCII SPE, под названием Al0(1,2,3,4,5). Пояснение: Al0 – спектр без поглотителя, Al1 – спектр с 1 слоем поглотителя и т.д.

Обработка результатов эксперимента

1. Выделить в полученных спектрах пики полного поглощения. Оценить площадь под пиками полного поглощения *P* (найти интегральное число частиц в пиках).

2. Вычислить функцию пропускания B(x), равную отношению P(x) к P(x = 0).

3. На основании полученных данных построить график B(x). Объяснить ход зависимости (пример приведен на рис. 10).



Puc. 10. Экспериментально полученная функция пропускания *B*(*x*) γ-излучения для свинцового поглотителя

4. Полученную в эксперименте функцию пропускания B(x) аппроксимировать экспоненциальной функцией (Пример приведен на рис. 11). Найти линейный коэффициент ослабления т γ -излучения Cs-137 в свинце.



5. Зная плотность свинца (ρ = 11,35 г/см³), вычислить массовый коэффициент ослабления μ.

6. Построить экспериментальную функцию пропускания B(x) в полулогарифмическом масштабе. Аппроксимировать полученную зависимость линейной функцией y(x) = ax + b. Найти линейный коэффициент ослабления $\tau \gamma$ -излучения Cs-137 в свинце.

7. Повторить задания 1–6 для экспериментальных результатов, полученных при использовании алюминиевых поглотителей (ρ = 2,7 г/см³).

8. Определить вклады комптоновского рассеяния и фотоэффекта в экспериментальный спектр γ -квантов. Выделить в амплитудном спектре, измеренном в отсутствии поглотителя, часть, которая соответствует комптоновскому рассеянию (см. рис. 6). Вычислить площадь под комптоновским распределением P_{κ} . Величина P_{κ} определяется числом γ -квантов, провзаимодействовавших в сцинтилляторе за счет комптонэффекта. Площадь под пиком полного поглощения (фотопиком) P, вычисленная в пункте 1, определяется числом γ -квантов, провзаимодействовавших в сцинтилляторе за счет комптон-эффекта. Так как коэффициент μ пропорционален числу актов взаимодействия, можно написать следующее соотношение:

$$P/P_{\rm K} = \mu_{\rm fr}/\mu_{\rm K}$$
,

где μ_{ϕ} , μ_{κ} – коэффициенты поглощения за счет фото- и комптонэффектов в веществе сцинтиллятора.

Поскольку полный коэффициент поглощения γ -квантов в веществе сцинтиллятора $\mu = \mu_{\phi} + \mu_{\kappa}$ известен и равен 0,076 см²/г, можно отдельно найти коэффициенты μ_{ϕ} и μ_{κ} .